【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成17年10月27日(2005.10.27)

【公開番号】特開2000-164794(P2000-164794A)
【公開日】平成12年6月16日(2000.6.16)
【出願番号】特願平10-335351
【国際特許分類第７版】
　ＨＯ１Ｌ　25/065
　ＨＯ１Ｌ　25/07
　ＨＯ１Ｌ　25/18
【ＦＩ】
　ＨＯ１Ｌ　25/08　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成17年9月8日(2005.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　【請求項１】　第１半導体チップと、
　第２半導体チップと、
　前記第１半導体チップのボンディングパッドが形成される表面上に延在する第１、第２、第３リードと、
　前記第２半導体チップのボンディングパッドが形成される表面上に延在する第４、第５、第６リードとを具備し、
　前記第１リードは、前記第４リードに電気的に接続され、
　前記第２リードは、前記第５リードに電気的に接続され、
　前記第３リードは、前記第６リードに電気的に接続され、
　前記第１半導体チップは、前記第１および前記第２リードと電気的に接続されると共に、前記第３リードとは電気的に絶縁され、
　前記第２半導体チップは、前記第４および前記第６リードと電気的に接続されると共に、前記第５リードとは電気的に絶縁され、
　前記第１および前記第２半導体チップは、前記第１リードに供給されるクロック信号に基づき動作し、
　前記第１半導体チップは、前記第２リードに供給される第１クロックイネーブル信号に基づいて低消費電力モードに遷移し、
　前記第２半導体チップは、前記第３リードに供給される第２クロックイネーブル信号に基づいて低消費電力モードに遷移し、
　前記第２クロックイネーブル信号は、前記第３リードを介して前記第６リードに供給されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】　請求項１記載の半導体装置において、
　前記半導体装置は、前記第１半導体チップのボンディングパッドが形成される表面上に延在する第７および第８リードと、前記第２半導体チップのボンディングパッドが形成される表面上に延在する第９および第１０リードとを更に具備し、
　前記第７リードは、前記第９リードと電気的に接続され、
　前記第８リードは、前記第１０リードと電気的に接続され、
　前記第１半導体チップは、前記第７および前記第８リードと電気的に接続され、

前記第２半導体チップは、前記第９および前記第１０リードと電気的に接続され、
前記第７リードには、前記第１および前記第２半導体チップに共通のアドレス信号が供給され、
前記第８リードには、前記第１および前記第２半導体チップに共通のデータ信号が供給され、
前記アドレス信号は、前記第７リードを介して前記第９リードに供給され、
前記データ信号は、前記第８リードを介して前記第１０リードに供給されることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】　請求項１または２記載の半導体装置において、
前記半導体装置は、前記第１半導体チップのボンディングパッドが形成される表面上に延在する第１１および第１２リードと、前記第２半導体チップのボンディングパッドが形成される表面上に延在する第１３および第１４リードとを更に具備し、
前記第１１リードは、前記第１２リードと電気的に接続され、
前記第１３リードは、前記第１４リードと電気的に接続され、
前記第１半導体チップは、ボンディングワイヤにより前記第１１リードと電気的に接続されると共に、前記第１２リードとは電気的に絶縁され、
前記第２半導体チップは、ボンディングワイヤにより前記第１４リードと電気的に接続されると共に、前記第１３リードとは電気的に絶縁され、
前記第１１リードには、第１チップセレクト信号が供給され、
前記第１２リードには、第２チップセレクト信号が供給され、
前記第２チップセレクト信号は、前記第１２リードを介して前記第１４リードに供給されることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】　請求項１から３のいずれか１項に記載の半導体装置において、
前記第１および第２半導体チップは、ＳＤＲＡＭであることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】　請求項１から４のいずれか１項に記載の半導体装置において、
前記第１半導体チップと前記第２半導体チップは、積層されるものであることを特徴とする半導体装置。